



(51) 国際特許分類6 H01L 21/82, 21/822, 27/04, 21/8242, 27/108	A1	(11) 国際公開番号 WO99/19905 (43) 国際公開日 1999年4月22日 (22.04.99)
(21) 国際出願番号 PCT/JP98/04581 (22) 国際出願日 1998年10月12日 (12.10.98) (30) 優先権データ 特願平9/278316 1997年10月13日 (13.10.97) JP 特願平9/297430 1997年10月29日 (29.10.97) JP (71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 富士通株式会社(FUJITSU LIMITED)[JP/JP] 〒211-8588 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 Kanagawa, (JP) (72) 発明者 ; および (75) 発明者 / 出願人 (米国についてのみ) 鈴木清市(SUZUKI, Seichi)[JP/JP] 足立和宏(ADACHI, Kazuhiro)[JP/JP] 鈴木範之(SUZUKI, Noriyuki)[JP/JP] 秀島 修(HIDESHIMA, Osamu)[JP/JP] 川端健一(KAWABATA, Kenichi)[JP/JP] 大槻雅也(OHTSUKI, Masaya)[JP/JP] 早矢仕学(HAYASHI, Manabu)[JP/JP] 矢柳純一(YAYANAGI, Junichi)[JP/JP]	〒211-8588 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内 Kanagawa, (JP) 片山雅也(KATAYAMA, Masaya)[JP/JP] 〒487-0013 愛知県春日井市高蔵寺町二丁目1844番2 富士通VLSI株式会社内 Aichi, (JP) (74) 代理人 弁理士 伊東忠彦(ITO, Tadahiko) 〒150-6032 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー32階 Tokyo, (JP) (81) 指定国 JP, KR, US. 添付公開書類 国際調査報告書	
<p>(54)Title: SEMICONDUCTOR DEVICE HAVING FUSE AND FABRICATION METHOD THEREOF</p> <p>(54)発明の名称 ヒューズを有する半導体装置およびその製造方法</p> <p>(57) Abstract</p> <p>A semiconductor device comprising a fuse and an etching stopper film covering the fuse wherein an optical window for exposing the etching stopper film and a contact hole for exposing a conductor pattern are formed simultaneously, and an insulation film covering the fuse is exposed from the optical window by dry etching the etching stopper film.</p> <div style="text-align: right;"> <p>A</p> <p>B</p> <p>C</p> </div>		